2P028

希ガスーシクロアルカン van der Waals 錯体の構造の量子化学計算 (城西大理) 〇宮川 粛, 紺野 東一, 尾崎 裕

Quantum Chemical Calculations on the Structures of Rare Gas Cycloalkane van der Waals Complexes

(Josai University) OKiyoshi Miyagawa, Toichi Konno, Yasushi Ozaki

【序】

我々は昨年、希ガス(Rg=Ne、Ar、Kr)ーシクロブタン(C4H8) の構造とエネルギーの関係を量子化学計算、MP2/ aug-cc-pvdz により調べ、4 個の C 原子が平面内にないため に、最安定構造において、希ガスはシクロブタンの平面の中 心上ではなく少し偏った位置に存在する double minimum の ポテンシャルとなること、および、シクロブタンの puckering 運動の障壁が、希ガスを付加することで変化することを報告 した。<sup>1)</sup> しかし、MP2/ aug-cc-pvdz の計算では puckering の

障壁は917 cm<sup>-1</sup>となり、実験値、510 cm<sup>-1</sup>よりもかなり高 い。<sup>2)</sup> そこで、本研究ではより精度の高い計算方法 CCSD(T)と基底系 aug-cc-pvdz を用いて同様 の計算を行って比較した。また希ガスとシクロペンタン(C5H10)の van der Waals 錯体 Rg-C5H10 についても計算を行い構造を比較した。

【最安定構造の計算結果と比較】 図1の構造を使い、計算方法 CCSD(T)/ aug-cc-pvdz を用いて Counterpoise 補正を加え Rg-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub> の構造最適化とエネルギー計算を行 い最安定構造を探した。*θ*=90°を中 心として対称になっており、 $\theta$ =67°、 反対側 θ=113°に最安定構造が存在 し、double minimum のポテンシャル であることが確認された。計算方法  $CCSD(T) / aug-cc-pvdz \oslash Rg-C_4H_8$ 



図2 Rg-C4H8各角度における最安定エネルギー

のそれぞれの角度における最安定エネルギーをグラフ1に示す。各Rg-C4H8の最安定構造の分 子間距離 r は Ne-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>では 3.81Å、Ar-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>では 4.06Å、Kr-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>では 4.20Åとなり、希 ガス原子が大きくなると分子間距離は長くなった。各Rg-C4H8の最安定構造でのエネルギーE は Ne-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>では-77 cm<sup>-1</sup>、Ar-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>では-211 cm<sup>-1</sup>、Kr-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>では-249 cm<sup>-1</sup>となり、 希ガス原子が大きくなると  $Rg-C_4H_8$ のエネルギーE(-E が  $Rg-C_4H_8$ の結合エネルギー)は低 くなった。 $Rg-C_4H_8$ の $\theta$ に対するポテンシャルは double minimum であることから、各Rg-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>の最安定構造 θ=67°、113°のエネルギーと θ=90°の峠の位置のエネルギー差を求めると、  $Ne-C_4H_8$  では  $15cm^{-1}$ 、 $Ar-C_4H_8$  では  $32cm^{-1}$ 、 $Kr-C_4H_8$  では  $34cm^{-1}$  となり、double minimum



図1 Rg-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>の構造

の峠は希ガス原子が大きくなると高くなった。昨年の MP2/ aug-cc-pvdz の計算結果と比較すると  $\theta$  は約 2°大きくなった。MP2 より CCSD(T)が分子間距離 r は Ne の場合長くなり、Ar、Kr で は短くなり、エネルギーE は Ne の場合低くなり、Ar、Kr では高くなった。一方 double minimum の峠の高さは全ての希ガス原子で MP2 より CCSD(T)が低くなった。

【錯体形成と puckering 運動】

シクロブタンの puckering の障壁は、 昨年の MP2/ aug-cc-pvdz での 917 cm<sup>-1</sup> と比べて今回の CCSD(T)/ aug-cc-pvdz で は 769 cm<sup>-1</sup>となり実測値 510 cm<sup>-1</sup>に近 づいた(図 3)。この安定構造と峠の平面構 造に希ガスが付加するとそれぞれ安定し て障壁の高さが変わる。今回の Ar-C4H8 の計算結果を図 3 に示した。ここでは障 壁の変化を示すために C4H8 と Ar-C4H8 それぞれの最安定エネルギーを0 cm<sup>-1</sup>と して一致させて比較した。なお、希ガス



ーシクロブタンで puckering が起きると、図 3 の右端上の構造となるが、最終的には希ガスもシ クロブタンの形に合わせて x 軸の上方から y 軸の上方に動き、左端の構造を 90°回転させた最初 と同じ安定構造に戻る。このエネルギー差は double minimum の障壁のエネルギーであり Ar-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>の場合 32 cm<sup>-1</sup>であり、全体の障壁と比べると 1 桁以上小さい。このように、希ガスをつけ ることによって puckering 運動をコントロールできるかどうかを調べるため、シクロブタンのみ

表1 パッカリング振動のバリア

	バリアの高さ/cm <sup>-1</sup>
$C_4H_8$	769
$Ne-C_4H_8$	734
$Ar-C_4H_8$	694
$Kr-C_4H_8$	686

の puckering 運動のエネルギー障壁と、希ガスを付けた 場合の puckering 運動のエネルギー障壁を計算した結果、 障壁は表 1 のように求められた。計算結果から Ne では 35 cm<sup>-1</sup>、Ar では 75 cm<sup>-1</sup>、Kr では 83 cm<sup>-1</sup>エネルギ ー障壁が低くなった。このことから例えば、200 cm<sup>-1</sup> 以下のエネルギー障壁持つシクロアルカンがあれば希ガ スをつけることで障壁は約半分になる。

【シクロペンタンー希ガス van der Waals 錯体】

同様のパッカリングと希ガスとの相互作用はシクロペンタンでも考えられる。シクロペンタン の構造を計算方法 MP2、CCSD、基底系 6-311G(d,p)、6-311+G(d,p)、aug-cc-pvdz などで最適化 すると、どの計算方法と基底系の組み合わせでも、五員環を形成する炭素原子のうち 4 個はほぼ 平面上にあり、1 個だけ大きく平面から離れた構造であった。4 個の 1 個は残り 3 個の形成する 平面から 0.19Å離れているだけであり、5 個目の原子は約 0.67Å離れていた。4 個を平面と考え るとシクロペンタンの構造は基本的にシクロブタンと同じ構造であり、パッカリング運動が付加 した希ガスの影響を受けることになる。シクロペンタンー希ガス錯体の計算結果は討論会で報告 する。

## 【文献】

1) 宮川等 第6回分子科学討論会 2012 東京 3P-072 2) T. Egawa et al., J. Chem. Phys. 86. 6018 (1987).